

X 1, 5, 7, 9, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 33, 35, 36
 38, 39, 40, 44, 51, 52, 57
 1997年 3月 電子工學會論文誌 第34卷 D編 第3號

論文97-34D-3-10

A : 47, 52, 56

59, 63, 67
68, 72, 76, 80, 84, 85, 86, 89

고밀도 플라즈마에서 규소산화막을 마스크로 이용한 백금박막의 패터닝

(Patterning of Pt thin films using SiO_2 mask
in a high density plasma)

李 喜 習*, 李鍾根*, 朴世根*, 鄭揚喜**

(Hee Seup Lee, Jong Geun Lee, Se-Geun Park, and Yang Hee Jung)

要 摘

저 식각용과 식각잔여물의 형성이라는 문제점을 갖고있는 백금박막의 전식식각공정을 명소를 기본 공정기체로 한 ICP를 이용하여 연구하였다. 보다 높은 식각율을 얻기 위해 공정온도를 높이는 대신 규소산화막을 패터닝 마스크로 사용하였다. 공정반응기체에 첨가된 산소나 아르곤의 영향을 우선 살펴보았으며, 반응기내의 압력, 공정기체의 유량, 플라즈마인 전력과 바이어스 전력 등에 대한 영향을 식각율과 식각선택비를 측정함으로써 조사하였다. 물리적 스팍터링효과가 주요 식각기구이지만 고에너지 이온의 에너지의 도용을 받는 화학적 반응 역시 큰 영향을 주고 있음을 알게 되었다. 규소산화막과의 선택비를 2.0 이상으로 하면서 백금박막의 식각율은 200 nm/min이상인 공정조건을 찾아 서브 마이크론의 백금피연을 형성하였다.

Abstract

Inductively coupled Cl_2 plasma has been studied to etch Pt thin films, which hardly form volatile compound with any reactive gas at normal process temperature. Low etch rate and residue problems are frequently observed. For higher etch rate, high density plasma and higher process temperature is adopted and thus SiO_2 is used as for patterning mask instead of photoresist. The effect of O_2 or Ar addition to Cl_2 was investigated, and the chamber pressure, gas flow rate, source RF power and bias RF power are also varied to check their effects on etch rate and selectivity. The major etching mechanism is the physical sputtering, but the ion assisted chemical reaction is also found to be a big factor. The process can be optimized to obtain the etch rate of Pt up to 200nm/min and selectivity to SiO_2 at 2.0 or more. Patterning of submicron Pt lines are successfully demonstrated.

1. 서 론

최근의 초고집적화 기술에서 PZT, PLZT, 또는 BST등의 강유전체나 고유전율 절연막이 MOS 트랜지

스터의 게이트 절연막이나 DRAM의 전하저장용 축전기 절연막으로 사용될 가능성이 높아짐에 따라 그의 전극재료로 사용되는 백금(Pt)이 새로이 관심을 받게되었다. PZT나 BST제열의 박막은 세자 과정에 산소 분위기에서의 고온서리(600°C 이상)를 포함하기 때문에 이러한 환경을 견딜 수 있는 전도성재질의 일부진극이 마련되어야하며, 그 동안 RuO_2 나 Pt가 많이 사용되어 왔다. 이러한 전극재료를 초고집적 절연회로소자에 사용되기 위해서는 전기적, 재료학적 특성 이외에도 전극의 형성에 기존의 금속회로공정을 적용할 수 있는지를 종합적으로 검토해야 한다. Pt 박막의 전식식각에 대한

* 正會員 仁荷大學校 物體暨 薄膜技術研究所
(Research Institute of Semiconductor and Thin Film Technology, Inha University)

** 正會員 麗水 水產大學 電氣工程系
(Department of Electrical Engineering, Yosu National Fisheries University)

接受日字 1996年11月14日, 收到日字 1997年3月5日

것으로써, Pt는 일반적인 식각공정온도 (100°C 이하)에서는 어떤 공정기체와도 치발성의 화합물을 쉽게 형성하지 않으며, 따라서 낮은 식각율과 잔여물형성 등의 문제점을 안고 있는 것으로 알려져있다.

C. H. Chou 등¹¹⁾의 마이크로파에 의한 산소 플라즈마 연구는 down stream 방식으로써 Pt 무게의 감소량을 측정하여 식각율을 계산하였다. 순수한 화학반응이 주 식각 반응기구임을 보였으나, 패터닝을 시도하지 않았다. CF₄ Plasma를 이용하여 PVPZT/Pt 구조의 소자를 일괄적으로 제작한 J. J. Van Giabbeek 등¹²⁾의 연구결과도 보고되어 있으나, 이 연구에 의하면 Pt의 식각은 화학적 반응에 의한 것이라기보다는 이온의 물리적 스파터링효과에 의한 것이었다. 이 연구에서는 Pt 식각율은 2.0nm/min 정도이며 강광체와의 식각선백비는 0.1정도이었고 CF₄ 플라즈마를 Pt와 PZT의 식각에 모두 이용하였다. 알루미늄이나 구리 박막의 건식 식각 연구에 주로 사용되고 있는 Cl₂ 플라즈마를 RF 아그네트론과 ECR로 발생시킨 식각실험에서는 Pt 식각율을 150nm/min 이상으로 얻을 수 있었다.¹³⁾ 순수한 물리적 스파터링이 주 식각반응이지만 Cl₂에 의한 화학반응도 식각율의 증대에 기여한다고 보고하였다. Yokoyama 등¹⁴⁾는 공정온도를 300°C 까지 올리기 위하여 강광체 대신에 spin on glass(SOG)를 마스크로 사용하였고 고밀도의 ECR 플라즈마를 이용하여 Pt의 식각율을 200nm/min 정도까지 얻을 수 있었으나 SOG 마스크와의 선백도는 1.0 이하이었다. W. J. Yoo 등¹⁵⁾은 MERIE Ar/Cl₂/O₂의 플라즈마를 이용한 식각실험에서 Pt의 식각율을 120nm/min 정도, 산화막 마스크와의 선백도는 1.2 정도를 얻었다. 이 실험에서는 또한 첨가기체의 런에 따라 백금박막의 식각각도를 개선할 수 있음을 보였다.

본 연구에서는 높은 식각율을 얻기 위하여 고밀도 플라즈마의 ICP(inductively coupled plasma)를 사용하여 공정온도를 150°C 정도로 하였다. PECVD SiO₂를 마스크로 사용하여 향상된 선백비를 얻기 위하여 Cl₂ 플라즈마에 O₂ 또는 Ar을 첨가하여 반응기구를 조사하였고 그 결과를 이용하여 서브마이크론의 Pt 박막의 패터닝을 시도하였다.

II. 실험 및 결과

본 실험에서 사용한 반응로는 planar 안테나를 이용

한 ICP로써 고밀도의 플라즈마를 발생시킬 수 있다. 그림 1에 ICP 반응로의 개략적인 구조가 제시되어 있다. 반응로의 모든 벽은 양극산화 알루미늄으로 제작하였고 수정 창의 창구가 설치되어 optical emission을 관찰할 수 있다. 상판 위의 안테나에 source RF power를 걸어 고밀도 플라즈마를 발생시키며, 웨이퍼 스테이지를 경한 하부전극에 bias RF power를 걸 수 있도록 제작하였다. 공정기체가 균일하게 유입되어지도록 반응로 안에 gas ring을 설치하였다. 또한 웨이퍼 스테이지와 안테나 사이의 거리를 조절할 수 있도록 제작되었다.

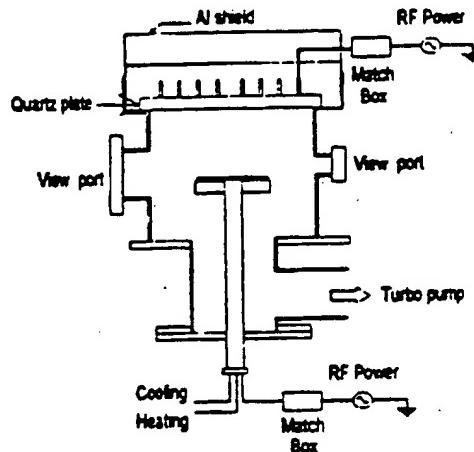


그림 1. ICP etcher의 구조도
Fig. 1. Schematic diagram of ICP etcher.

Single Langmuir probe를 사용하여 전자온도와 이온밀도를 측정하였다. 1KW의 source RF power와 10mTorr의 공정압력에서 전자온도는 4~6 eV정도, 그리고 이온밀도는 $10^{12}/\text{cm}^3$ order로써 높음을 확인할 수 있었다. Si 기판에 열간화막을 형성한 후 Ti 박막을 20nm , 그리고 Pt 박막을 300nm 스파터 증착 시킨 시료와 PECVD SiO₂를 증착한 시료를 일부만 가지고 일정시간동안 식각을 행하였으며, 이 때 생긴 step의 높이를 측정하여 Pt와 SiO₂의 식각율을 각각 구하고 선백비를 계산하였다.

본 실험 온도인 150°C 정도에서는 치발성 화합물을 형성하기 어렵다고 보여지므로 Pt 식각 기구는 물리적 스파터링이 주종을 이를 것이라고 예상하여 Cl₂와 질량 이 거의 비슷한 Ar을 혼합하면서 식각 실험을 한 결과가 그림 2에 나타나 있다. Ar은 Pt와 화학적 반응을 하지 않기 때문에 100% Ar 플라즈마에서는 순수한

물리적 스파터링 기구에 의해 식각 되는 것으로 알려져 있다. Cl_2 의 농도가 커지는 경우에는 식각율이 100% Ar에서 보다 점차 커지는 것을 볼 수 있는데, 이는 Cl_2 에 의한 화학반응이 첨가되어 식각율이 증대된 때문으로 생각된다. 100% Ar 플라즈마에서는 quartz view window와 ICP의 안테나 아래에 있는 quartz plate에 Pt가 deposition 되는 현상을 볼 수 있었는데 이는 Ar 이온에 의한 Pt의 sputter deposition 때문으로 믿어진다. 그러나 Cl_2 가 첨가되었을 때는 이러한 현상이 나타나지 않았다. 따라서 Cl_2 가 첨가되었을 때에는 Pt가 순수한 원자나 분자 형태로 남아 있기보다는 PtCl_x ($x=2$ or 4) 같은 화합물을 형성하기 때문으로 생각된다.^[4] OES(optical emission spectrometer)를 이용하여 Pt radical peak인 266nm^[6] 근처를 가스의 혼합비에 따라 측정한 결과가 그림 3에 나타나 있다. 100% Ar일 때에 강하게 나타나던 Pt의 원자 peak인 Cl_2 가 혼합되면서 약해지는 것을 볼 수 있다. Pt의 식각율은 증가하였으나 Pt emission peak의 세기가 감소하는 것은, PtCl_x 의 형성으로 Pt peak의 위치가 266nm로 부터 이동하였기 때문으로 믿어진다. 100% Cl_2 plasma에서 Pt의 식각율은 200nm/min 이상으로 증가하였으나, SiO_2 의 선택비는 1:0정도로 그림 2에서 보듯이 작아졌다.

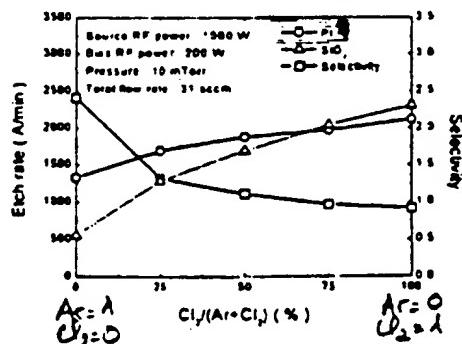


그림 2. Ar과 Cl_2 의 혼합비에 따른 Pt와 SiO_2 의 식각율과 선택비의 변화

Fig. 2. Etch rate and selectivity as a function of Ar and Cl_2 gas contents.

선택비를 개선하기 위하여 Cl_2 에 O_2 를 추가하여 실험한 결과가 그림 4에 나타나있다. O_2 가 25%, Cl_2 가 75%이었을 때 식각율이 100% Cl_2 의 경우보다 식각율이 다소 높아졌다. 이러한 증가는 O_2 에 의해 PtO_x 의 화학반응이 식각에 추가로 기여하기 때문이라고 생각

되어지며, 그 이상의 O_2 가 첨가되었을 때 식각율이 감소하는 것은 O_2 의 질량이 Cl_2 에 비해 작기 때문에 물리적 스파터링에 의한 효과가 작아진 것으로 볼 수 있다.

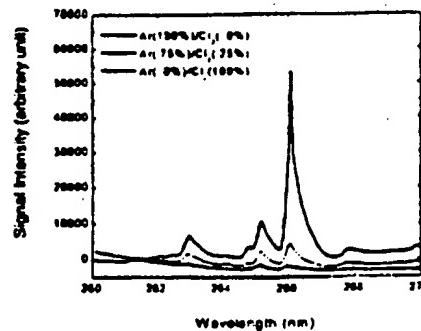


그림 3. Ar과 Cl_2 의 혼합비에 따른 266nm에서의 Pt 진유물 peak의 변화

Fig. 3. Optical emission spectra near 266nm Pt atom peak as a function of Ar and Cl_2 gas contents.

O_2 첨가에 따른 선택비의 개선은 그림 4에서 보듯이 최근 식각율의 변화는 적으나 SiO_2 의 식각율이 보다 더 감소하기 때문이다. 이는 공정기체 중의 산소 이온이나 전유물과 Si이 재결합하는 반응으로 인한 것으로 생각되며, 이러한 SiO_2 재형성은 Cl_2/O_2 플라즈마를 이용한 폴리실리콘 식각실험에서도 관찰되었다.^[7] 백금의 식각율이 230nm/min이상이며, SiO_2 의 선택비가 1.5정도인 25% O_2 와 75% Cl_2 의 혼합된 가스를 사용한 조건으로 다음 실험을 진행하였다.

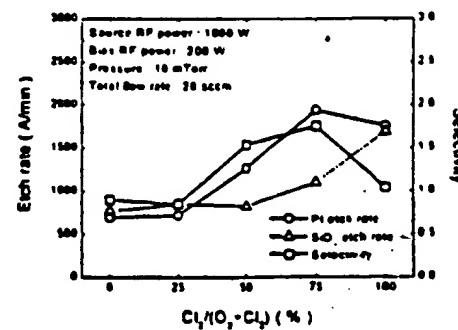


그림 4. O_2 와 Cl_2 의 혼합비에 따른 Pt와 SiO_2 의 식각율과 선택비의 변화

Fig. 4. Etch rate and selectivity as a function of O_2 and Cl_2 gas contents.

우선 그림 5는 식각의 비동방성과 이온의 운동에너

지와 관계가 있는 dc self-bias에 영향을 미치는 bias RF power를 변화시켰을 때의 식각율과 선택비의 측정 결과이다. Bias RF power가 증가함에 따라 식각율이 급격하게 증가하는 경향을 보이나 선택비는 감소하고 있다. Bias power가 증가하면 dc self-bias도 그림 6처럼 증가하게 되며 그로 인해 이온의 운동에너지도 증가한다. 따라서 식각반응에 있어서 물리적 스팍터링 효과가 주가 되면서 SiO_2 의 식각율이 보다 증가하게 되어 선택비가 감소한다.

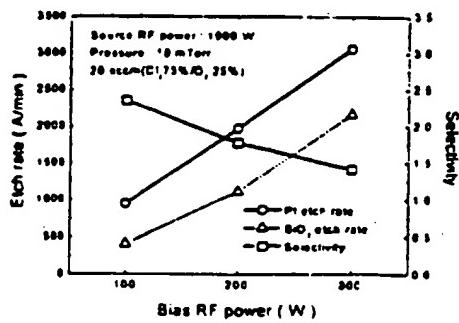


그림 5. 25% O_2 + 75% Cl_2 플라즈마에서 bias RF power에 따른 식각율과 선택비의 변화

Fig. 5. Etch rate and selectivity as a function of bias RF power in 25% O_2 + 75% Cl_2 plasma.

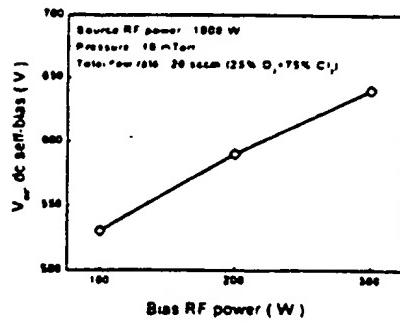


그림 6. 25% O_2 + 75% Cl_2 플라즈마에서 bias RF power에 따른 dc self-bias의 변화

Fig. 6. Dc self-bias as a function of bias RF power in 25% O_2 + 75% Cl_2 plasma.

Source RF power가 증가하면 플라즈마의 밀도가 증가하여 Pt 식각율이 증대됨을 관찰할 수 있었다. 그리고 chamber 압력이 5 mTorr에서 15 mTorr 까지는 식각율은 증가하나 그 이상에서는 감소하여 선택비는 10 mTorr에서부터 감소하기 시작한다. 또 기체의

유입량이 증가함에 따른 식각율과 선택비는 증가함을 알 수 있었다. 그림 7에는 RF 안테나와 웨이퍼 스테이지 사이의 거리를 변화시켰을 때의 식각율과 선택비를 나타내었다. 플라즈마의 중심으로부터 거리가 멀어짐에 따라 Pt의 식각율은 큰 변화가 없지만 SiO_2 의 식각율은 감소하여 선택비는 2.0 이상으로 높아지는 경향을 볼 수 있다. 거리에 따른 dc self-bias의 변화를 보면 거의 변화가 없음을 볼 수 있으므로 물리적 스팍터링 yield에는 큰 변화가 없다고 보여진다. 그러나 Pt의 식각율이 변화가 없거나 약간 증가하는 것으로 보아 화학적 반응에 의한 의존도가 높아진 것으로 생각된다.

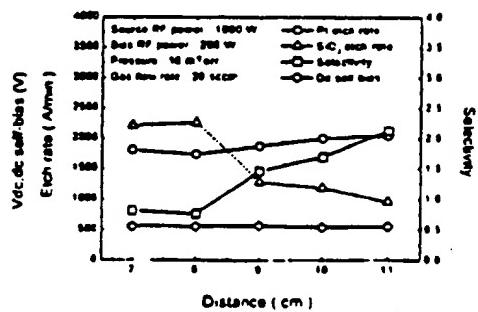


그림 7. 25% O_2 + 75% Cl_2 플라즈마에서 안테나와 웨이퍼 스테이지의 거리에 따른 식각율과 선택비와 dc self-bias의 변화

Fig. 7. Dc self-bias as a function of distance between antenna and wafer stage in 25% O_2 + 75% Cl_2 plasma.

Pt 전극의 패터닝을 위해 Si 기판 위에 250nm의 열 산화막을 키우고 Pt 박막과 열산막의 접착력 증대를 위하여 Ti 박막을 10nm를, 그리고 Pt 박막을 150nm을 스팍터링 법으로 증착시켰다. Hard 마스크로는 PECVD. 산화막을 증착하여 사용하였다. 실험용 패턴을 갖는 산화막 마스크의 line은 0.65 μm space는 0.75 μm 이다. 그리고 Pt 칙자와 산화막제거 후에 측정된 백금의 line은 0.6 μm space는 0.2 μm 였다. 한편 Pt의 패터닝을 하기 위하여 통제적 실험계획법으로 추가 실험을 수행하여 최적공정조건을 찾았다. 이는 공정 변수들을 효율적으로 실험 배열하고 최대의 식각율과 최대의 선택비를 동시에 주는 조건을 찾는 방법으로써, 그 결과 최적의 공정조건, 즉 식각율은 200nm/min이상이며 선택비는 2.0인 조건을 선택할 때에, source RF

power 1KW, bias RF power 100W, chamber 압력 10mTorr, 기체 유입량 20sccm, 안테나와 웨이퍼 스테이지 사이의 거리는 11cm이었고 기체 혼합비는 40% O₂와 60% Cl₂이었다.



그림 8. 40% O₂ + 60% Cl₂ 플라즈마에서 Pt 식각 후의 SEM 사진

Fig. 8. SEM cross section after Pt etch in 40% O₂ - 60% Cl₂ plasma.

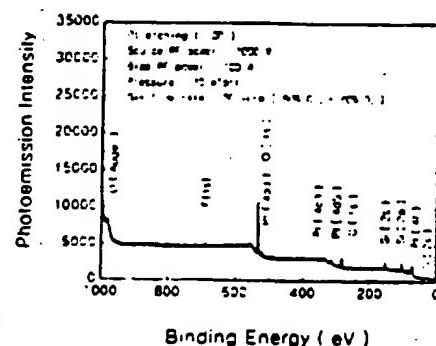


그림 9. 40% O₂ + 60% Cl₂ 플라즈마에서 Pt 식각 후의 wafer 표면의 XPS 스펙트럼

Fig. 9. XPS after Pt etching in 40% O₂ - 60% Cl₂ plasma.

그림 8은 이 조건에서 진행한 Pt 식각 후의 SEM 사진이다. 그림 9는 Pt 식각 후에 웨이퍼표면을 XPS로 분석한 것으로써 만일 비휘발성의 PtCl_x가 표면에 남아 있다면 Cl peak이 관찰되어야 하지만 이 XPS spectrum에는 Cl이 없음을 알 수 있다. 이는 식각 후의 생성물들이 높은 진공의 chamber에서 곧바로 pump out되었기 때문으로 생각된다. 그림 10은 40% O₂ + 60% Cl₂ 조건으로 Pt 식각 후 RIE에서 CF₄ plasma로 hard 마스크 산화막을 제거한 후의 SEM

사진이다. 물리적 스팍터링에 의한 식각이나 비휘발성 화합물 형상에 잊어났을 때 관측될 수 있는 울타리 (fencing) 현상, 즉 외벽에 친유물이 쌓중착되는 현상이 없음을 알 수 있다.



그림 10. CF₄ plasma로 마스크 산화막 식각 후의 SEM 사진

Fig. 10. SEM cross section after Pt etch in CF₄ plasma.

III. 결론

Pt의 식각유도 증대시키기 위하여 ICP 고밀도 Cl₂ 플라즈마를 이용하였다. Pt 식각이 물리적 스팍터링 기구인 Ar 플라즈마에 비하여 Cl₂ 플라즈마에서는 화학 반응이 추가되어 식각율이 증대되었으나 SiO₂의 식각비는 감소되었다. Cl₂에 O₂를 첨가함으로써 SiO₂의 식각율이 Pt보다 상대적으로 높아지면서 선택비는 개선이 되었다. 공정변수의 최적화를 통하여 식각율은 200nm/min 이상이면서 SiO₂ 마스크에 대한 선택비를 2.0이상으로 할 수 있었으며, 이는 과거의 다른 연구결과보다 우수한 것이었다. SiO₂의 hard 마스크를 이용하여 sub-micron의 Pt 학막 패터닝을 시도하였으며, 친유물이나 울타리(fencing) 현상이 없는 공정이 가능함을 보였다. 200nm 두께 이상의 백금 학막을 초고침 적 기억소자에서의 하부 측전전극으로 사용할 경우에서는 침직도 증대에 식각각도가 중요하기 때문에 이에 대한 연구가 필요하다.

감사의 글

* 본 논문은 1996년도 인하대학교 교내연구비지원으로 수행되었으며, 산화막 재단의 시료를 제공하여준 삼성전자 반도체연구소에 감사를 드립니다.

참 고 문 헌

- [1] C. H. Chou and J. Phillips, "Platinum metal etching in a microwave oxygen plasma" *J. Appl. Phys.* vol. 68, pp 2415- 2423, 1990.
- [2] J. J. Van Glabbeek, G. A. C. M. Spierings, M. J. E. Ulenaers, G. J. M. Domans and P. K. Larsen, "Reactive Ion Etching of Pt/PbZrTiO₃/Pt Integrated Ferroelectric Capacitors" *Mat. Res. Soc. Symp. Proc.* vol. 310, pp 127-132, 1993.
- [3] K. Nishikawa, Y. Kusumi, T. Oomori, M. Hanazaki and K. Namaba, "Platinum Etching and Plasma Characteristics in RF Magnetron and Electron Cyclotron Resonance Plasmas" *Jpn. J. Appl. Phys.* vol. 32, pp 6102-6108, 1993.
- [4] S. Yokoyama, Y. Ito, K. Ishihara, K. Hamada, S. Ohnishi, J. Kudo and K. Sakiyama, "High-Temperature Etching of PZT Pt/Ti/V Structure by High Density ECR Plasma" *Jpn. J. Appl. Phys.* vol. 34, pp 767-770, 1995.
- [5] W. J. Yoo, et al., "Control of Etch Slope during Etching of Pt in Ar/Cl₂/O₂ Plasmas" *Jpn. J. Appl. Phys.* vol. 35, pp 2501-2504, 1996.
- [6] *Handbook of Chemistry and Physics* (CRC Press, 1995~1996) 76th ed.
- [7] S. C. McNevin, "Radio Frequency Plasma Etching of Si/SiO₂ by Cl₂/O₂: Improvements Resulting from the Time Modulation of the Processing Gases" *J. Vac. Sci. Technol. A*, vol. 9, no. 3, pp 816-819, 1991.

저 자 소 개



주 홍 집(正會員)

1971년 10월 23일생. 1995년 인하대학교 전자재료공학과 졸업 (공학사). 1997년 동 대학원 전자재료공학과 졸업 (공학석사).



주 홍 집(正會員)

1960년 5월 18일생. 1983년 인하대학교 응용물리학과 졸업 (공학사). 1991년 동 대학원 응용물리학과 졸업 (공학석사). 1993년 ~ 현재 인하대학교 전자재료공학과 박사과정.



朴世根(正會員)

1992년 6월 19일생. 1974년 서울대학교 전자공학과 졸업 (공학사). University of Texas at Austin 졸업 (1981년 석사, 1985년 Ph. D.). 1986년 ~ 1988년 LG반도체 MOS 기술부장. 1988년 3월 ~ 현재 인하대학교 전자전기컴퓨터공학부 교수. 1996년 1월 ~ 현재 대한전자공학회 반도체, 재료 및 부품 연구회 위원장. 1995년 10월 ~ 현재 인하대학교부설 반도체 및 박막기술연구소 부소장. 주관심분야는 반도체공정 및 장비개발, 통계처리에 의한 공정최적화, LCD용 TFT 소자 등입니다.



朴世根(正會員)

1960년 12월 25일생. 1983년 단국대학교 응용물리학과 졸업 (공학사). 1985년 인하대학교 응용물리학과 졸업 (공학석사). 1993년 인하대학교 응용물리학과 졸업 (공학박사). 1988년 ~ 1995년 LG 반도체 선임연구원. 1995년 ~ 현재 국립 여수수산대학교 전기공학과 전임강사.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning

~~Scanning and Indexing of Original Document~~

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.